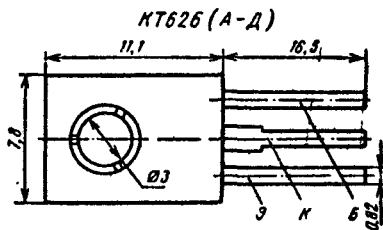


# КТ626 (А, Б, В, Г, Д)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р. Предназначены для применения в усилителях и генераторах коротковолнового диапазона и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КЭ}=2$  В,  $I_K=0,15$  А:

$T=+25^\circ\text{C}$ :

КТ626А, КТ626Д	40...250
КТ626Б	30...100

КТ626В	15...45
КТ626Г	15...60

$T=+85^\circ\text{C}$ :

КТ626А, КТ626Д	40...500
КТ626Б	30...200
КТ626В	15...90
КТ626Г	15...120

$T=-40^\circ\text{C}$ :

КТ626А, КТ626Д	20...250
КТ626Б	15...100
КТ626В	8...45
КТ626Г	8...60

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КЭ}=10$  В,  $I_B=30$  мА, не менее:

КТ626А, КТ626Б	75 МГц
КТ626В, КТ626Г, КТ626Д	45 МГц

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер КТ626А, КТ626Б при  $I_K=0,5$  А,  $I_B=0,05$  А и КТ626В, КТ626Г, КТ626Д при  $I_K=0,5$  А,  $I_B=0,1$  А, не более:

1 В

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при  $U_{КБ}=10$  В,  $I_B=30$  мА,  $f=5$  МГц:

500 пс

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КВ0}=10$  В:

150\* пФ

Обратный ток коллектора, не более:

КТ626А при $U_{КВ0}=30$ В	10 мкА
$U_{КВ0}=45$ В	1 мА

КТ626Б, КТ626В при $U_{КВ0}=30$ В, КТ626Г, КТ626Д при $U_{КВ0}=20$ В	150 мкА
--	---------

КТ626Б при $U_{КВ0}=60$ В и КТ626В при $U_{КВ0}=80$ В	1 мА
---	------

Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭВ0}=4$  В, не более:

КТ626А	10 мкА
КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д	300 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

КТ626А	45 В
КТ626Б	60 В
КТ626В	80 В
КТ626Г, КТ626Д	20 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при  $R_{ЭБ}=100$  Ом:

КТ626А	45 В
КТ626Б	60 В
КТ626В	80 В
КТ626Г, КТ626Д	20 В

Постоянный ток коллектора

0,5 А

Импульсный ток коллектора

1,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при  $T_{*} \leq +60^\circ\text{C}$  6,5 Вт

при  $T_{*} = +85^\circ\text{C}$  4 Вт

Тепловое сопротивление переход — корпус

10 °C/Вт

Температура р-п перехода

+125 °C

Температура окружающей среды

-40 °C..  $T_{*} = +85^\circ\text{C}$

Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не выше +260 °C в течение не более 3 с.